

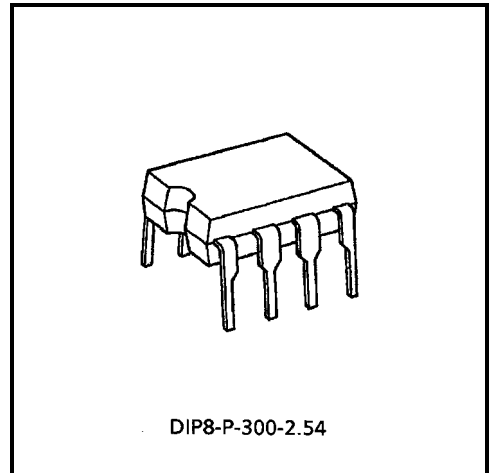
TD62476P, TD62477P, TD62478P, TD62479P

- TD62476P デュアルペリフェラル AND ドライバ
- TD62477P デュアルペリフェラル NAND ドライバ
- TD62478P デュアルペリフェラル OR ドライバ
- TD62479P デュアルペリフェラル NOR ドライバ

基本ゲート (NAND、AND、NOR、OR) の出力部にドライバを付加した 2 回路入り PERIPHERAL DRIVER です。

入力部論理レベルが TTL コンパチになっていることから、スタンダードランダムロジックとのインタフェースに最適です。

使用に当たっては熱的条件にご注意ください。

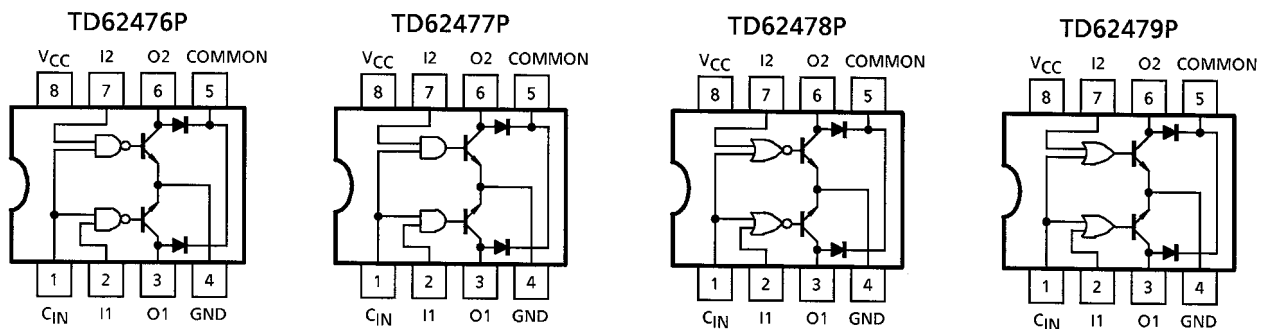


DIP8-P-300-2.54

質量: 0.45 g (標準)

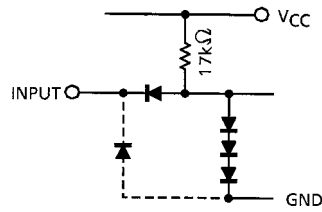
TD62476P			TD62477P			TD62478P			TD62479P		
INPUT		OUTPUT	INPUT		OUTPUT	INPUT		OUTPUT	INPUT		OUTPUT
C _{IN}	I		C _{IN}	I		C _{IN}	I		C _{IN}	I	
0	0	ON	0	0	OFF	0	0	ON	0	0	OFF
0	1	ON	0	1	OFF	0	1	OFF	0	1	ON
1	0	ON	1	0	OFF	1	0	OFF	1	0	ON
1	1	OFF	1	1	ON	1	1	OFF	1	1	ON

ピン接続図

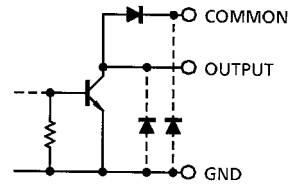


入出力等価回路

入力等価回路



出力等価回路



注: 破線で示すダイオードは寄生ダイオードですので使用しないでください。

最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧	V _{CC}	-0.5~7.0	V
入力電圧	V _{IN}	-0.5~5.5	V
出力耐圧	V _{CE(SUS)}	-0.5~35	V
出力電流	I _{OUT}	350	mA / ch
クランプダイオード耐圧	V _R	35	V
クランプダイオード順電流	I _F	300	mA
許容損失	P _D (注1)	0.9	W
動作温度	T _{opr}	-30~75	°C
保存温度	T _{stg}	-55~150	°C

注1: Ta = 25°Cをこえる場合は、7.2mW / °Cでディレーティングしてください。

推奨動作条件 (Ta = -30~75°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
電源電圧	V _{CC}	—	4.5	5.0	5.5	V
出力耐圧	V _{CE(SUS)}	—	0	—	35	V
出力電流	I _{OUT}	DC 1 回路	0	—	300	mA / ch
		DC 2 回路	0	—	200	
入力電圧	V _{IN}	—	4.5	—	V _{CC}	V
クランプダイオード耐圧	V _R	—	—	—	35	V
クランプダイオード順電流	I _F	—	—	—	300	mA
許容損失	P _D	—	—	—	0.4	W

電気的特性 (Ta = 25°C)

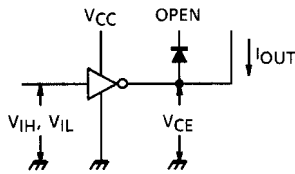
項目		記号	測定回路	測定条件	最小	標準	最大	単位		
入力電圧	“H”レベル	V_{IH}	1	—	2.0	—	—	V		
	“L”レベル	V_{IL}	1	—	—	—	0.8			
出力電流	“H”レベル	I_{OH}	2	$V_{CC} = 4.5V, V_{IH} = 2.0V$ $V_{IL} = 0.8V, V_{OH} = 35V$	—	—	10	μA		
出力電圧	“L”レベル	V_{OL}	3	$V_{CC} = 4.5V$ $V_{IH} = 2.0V$ $V_{IL} = 0.8V$	$I_{OUT} = 100mA$	—	0.15	0.30	V	
					$I_{OUT} = 200mA$	—	0.28	0.45		
					$I_{OUT} = 300mA$	—	0.45	0.60		
入力電流	“H”レベル	I_{IH}	4	$V_{CC} = 5.5V, V_{IN} = 5.5V$	—	—	10	μA		
	“L”レベル	I_{IL}	5	$V_{CC} = 5.5V, V_{IN} = 0.4V$	—	-0.26	-0.4	mA		
C_{IN}					—	-0.52	-0.8			
クランプダイオード電流		I_R	6	$V_{CC} = 4.5V, V_R = 35V$	—	—	10	μA		
クランプダイオード順電圧		V_F	7	$V_{CC} = 4.5V, I_F = 300mA$	—	1.5	1.75	V		
消費電流	出力“H”レベル	TD62476P	I_{CCH}	5	$V_{CC} = 5.5V$	$V_{IN} = 5V$	—	8.4	14	mA
		TD62477P				$V_{IN} = 0V$	—	0.6	0.85	
		TD62478P				$V_{IN} = 5V$	—	9	14	
		TD62479P				$V_{IN} = 0V$	—	1.1	1.8	
	出力“L”レベル	TD62476P	I_{CCL}	4		$V_{IN} = 5V$	—	38	55	
		TD62477P				$V_{IN} = 0V$	—	36	53	
		TD62478P				$V_{IN} = 5V$	—	39	56	
		TD62479P				$V_{IN} = 0V$	—	36	63	

スイッチング特性 (Ta = 25°C)

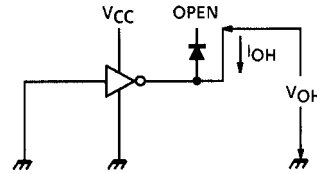
項目		記号	測定回路	測定条件	最小	標準	最大	単位
伝達時間	“H”レベル	t_{pLH}	—	$C_L = 15pF, R_L = 120\Omega$	—	0.7	—	μs
	“L”レベル	t_{pHL}	—		—	0.2	—	

測定回路

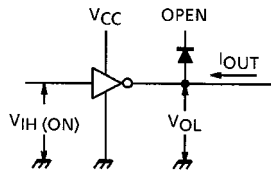
1. V_{IH}, V_{IL}



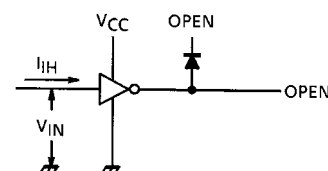
2. I_{OH}



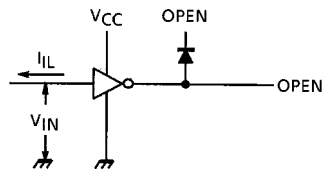
3. V_{OL}



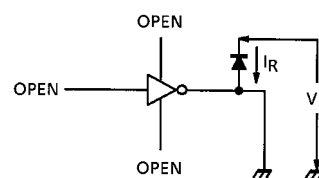
4. I_{IH}, I_{CCL}



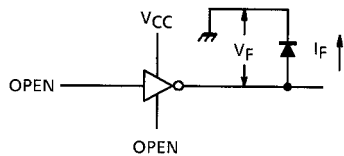
5. I_{IL}, I_{CCH}



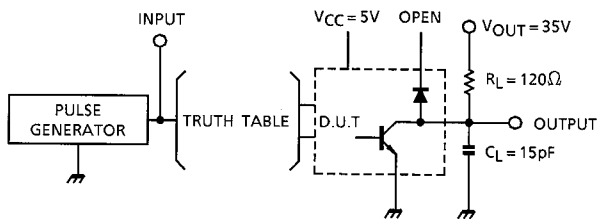
6. I_R



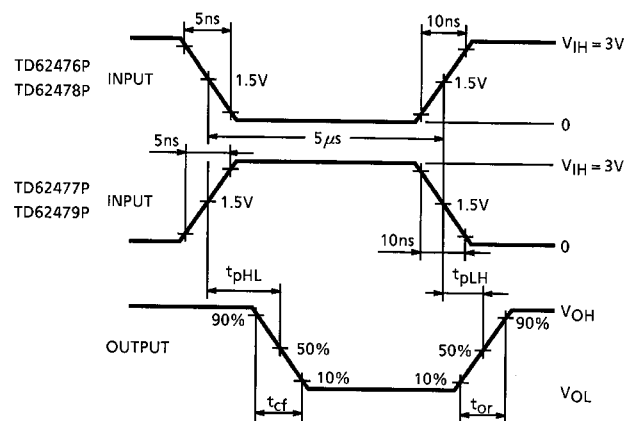
7. V_F



スイッチング特性測定回路



測定波形



応用上の注意点

本製品は、過電流・過電圧保護回路などのプロテクション回路を搭載した製品ではありません。

過電流・過電圧が印加された場合は破壊の可能性があります。

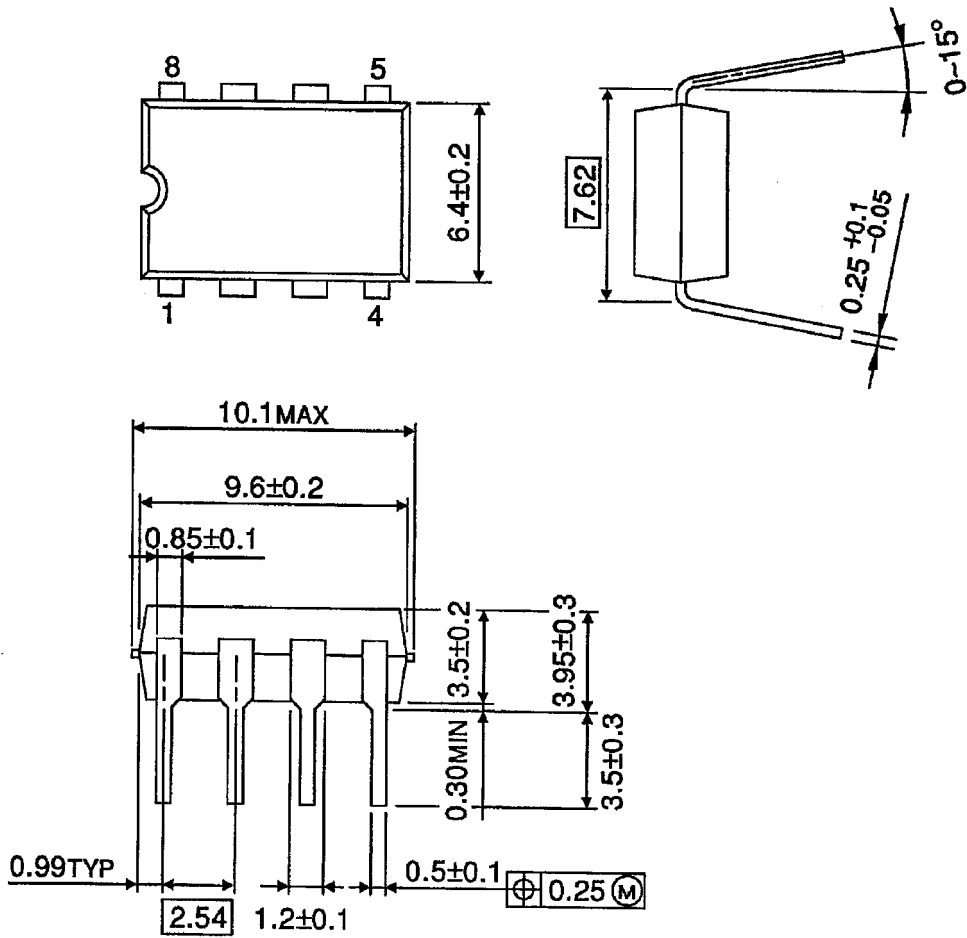
つきましては過電流・過電圧が印加されないよう、設計時は十分ご配慮ください。

また、出力間ショート、および出力の天絡、地絡時に IC の破壊の恐れがありますので出力ライン、COMMON ライン、GND ラインの設計は十分注意してください。

外形図

DIP8-P-300-2.54

単位 : mm



質量: 0.45 g (標準)

当社半導体製品取り扱い上のお願

000629TBA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている製品は、外国為替および外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものです。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。